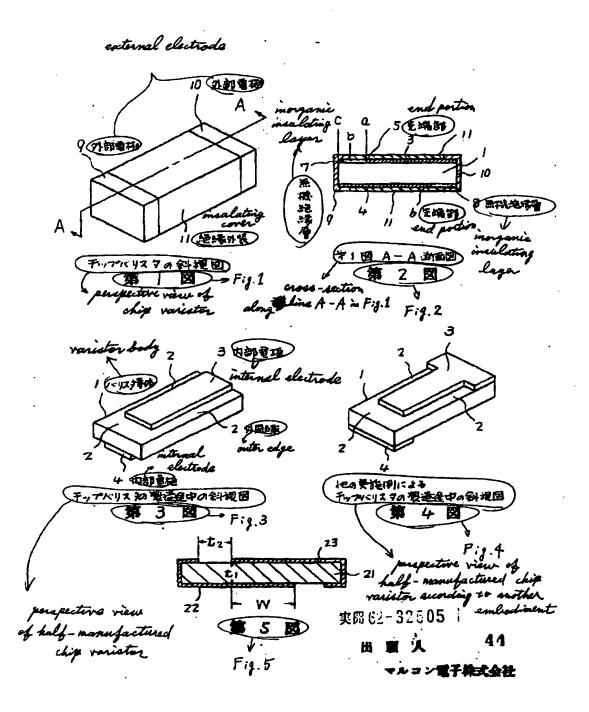
The invention relates to a chip varistor having improved electrodes and insulating structure. Please see Fig. 2.



32505

Ref. 3

⑩日本国特許庁(JP)

①実用新案出願公開

母 公開実用新案公報(U)

昭62-32505

@Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和62年(1987)2月26日

H 01 C 7/10 1/02

2109-5E 7303-5E

審査請求 未請求 (全 頁)

❷考案の名称

チップバリスタ

②実 関 昭60-124915

**登出 顧昭60(1985)8月13**日

创考 案 者 桃 木

孝 道

長井市幸町1番1号 マルコン電子株式会社内

⑦考 案 者

佐 藤 武 史

長井市幸町1番1号 マルコン電子株式会社内

①出 関 人

マルコン電子株式会社

長井市幸町1番1号



明 和 書

1. 考案の名称

チップパリスタ

- 2. 実用新案登録請求の範囲

  - (2) 絶縁外装が無機または高分子絶縁材からなることを特徴とする実用新案登録請求の範囲第 (1) 項記載のチップパリスタ。
- 3. 考案の詳細な説明

[考案の技術分野]

本考案は電極および絶縁構造を改良したチップ



パリスタに関する。

[考案の技術的背景とその問題点]

近年、パリスタの用途拡大に伴いプリント基板に相込み使用される小形で高密度実装化に適した チップパリスタの需要が増大してきている。

従来、これらチップバリスタの一般構造としては第5図に示すように例えば酸化亜鉛を主成分としたセラミック粉末を成形焼結した角板状のバリスタ素体(21)の対向両側面を介して反対面の一部分まで連接するよう電極(22)(23)を形成しバリタ素体(21)厚さt1を介して垂直に対向する電極(22)(23)間Wを特性有効部としたものがある。

しかして、このように構成してなるチップバタスタの場合電極 (22) (23) 間距離 t 2 はバリスタな体 (21) 厚させ 1 より大きくなる 逆の関係になった せんぱならない。 つまりこれが逆の関係にずるにはバリスタ特性 くなる。ところでチャーしての関係しているためにはバリスタ素体 (21)の厚さとしての



厚みを確保しなければならないが、前述のように tau の関係、すなわち同一面で相対する電 極の間隔を素体の厚みより大きくがある。 特性の間にはなり、からないが、前述のようで電 を素体の厚かより、カーロのとしまるができる。 特性有効部はパリスタ素体自体の大きに場 ものよくなり必ずしも小形で高密度実装化のた。 要求を十分に満足するものとは言えなかった。

### [発明の目的]

本考案は上記の点に鑑みてなされたもので、バリスタ素体の面積をより有効に活用し、より小形で同じパリスタ特性を得ることができるチップパリスタを提供することを目的とするものである。 [考案の概要]



極を形成し、該外部電極部を除いた全面を無機または高分子絶縁材に被覆し絶縁外装を形成した構造とすることを特徴とするものである。

### [考案の実施例]

以下、本考案の一実施例につき図面を参照して 説明する。すなわち第1図~第3図に示すように 例えば酸化亜鉛、チタン酸パリウム、チタン酸ス トロンチウム。炭化硅素、酸化鉄などを主成分と し、他に数種類の金属酸化物を添加混合したセラ ミック粉末を角板状に成形焼桔してなるバリスタ 素体(1) 両面の三周辺に外周縁(2) を残して内部 電 極 (3)(4)を 対 称 に 形 成 し 、 該 内 部 雷 極 (3)(4)そ れぞれの先端部 (5)(6)に位置する前記外周線 (2) 面に硼硅酸鉛、硼硅酸亜鉛、硅酸鉛などを主成分 とし、これにコバルト、マンガン、ニッケル、ア ンチモン、クローム、鉄などの添加物を少なくと も 一 種 添 加 し た ガ ラ ス 材 、 ま た は 例 え ば 酸 化 亜 鉛 にリチウム、銅、ナトリウム、銀などを一種以上 含 む 舀 絶 禄 性 セ ラ ミ ッ ク 材 を 塗 布 焼 付 け し 無 機 絶 緑層(7)(8)をそれぞれ対称に形成する。つぎに前



記内には、3)(4)と3)(4)と3)(4)と3)(4)と3)(4)と3)(4)と3)(4)と3)(4)と3)(5)と4の世紀では、3)(4)と4の世紀では、3)(4)と4の世紀では、3)(4)と4の世紀では、3)(4)と4の世紀では、3)(4)と4の世紀では、4)と4の世紀では、4)の世紀のは、4)の世紀のは

以上のように構成してなるチップパリスタによれば、内部電極 (3)(4)それぞれの先端部 (5)(6)に位置する外周線 (2) 面に無機絶縁層 (7)(8)を形成しているが、該無機絶縁層 (7)(8)の耐電圧はパリスタ素体 (1) より高いのでa-b 間距離をパリス



タ素体 (1) 厚さ t が (1) の 電機 (3) (4) と が (4) と で (5) の で (5) が (6) の で (7) (8) を で で が (7) (8) を で で が (7) (8) を で で が (8) を で (1) の 電機 (1) の で (1) で

なお、上記実施例では内部電極の形状としては 第3図に示すものを前提にして説明したが、第4 図に示すようにパリスタ素体(1)の両面に凸字形 の内部電極(3)形状としたとしても同効であるこ とは勿論である。



#### [考案の効果]

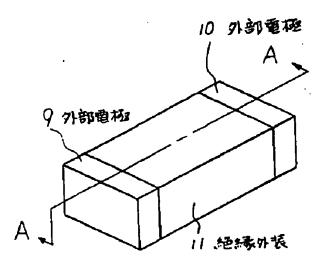
本考案によれば対向電極間の沿面放電を防止しより小形化で高密度実装化に貢献できる実用的価値の高いチップパリスタを得ることができる。

#### 4. 図面の簡単な説明

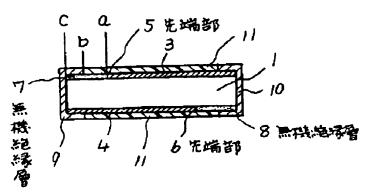
第1図〜第3図は本考案の一実施例に係るチップバリスタを示すもので第1図は斜視図、第2図は第1図A - A 断面図、第3図は内部電極を形成した状態の製造を中の斜視図、第4図は本考案の他の実施例に係る内部電極を形成した状態の製造途中のチップバリスタを示す斜視図、第5図は従来例に係るチップバリスタを示す正断面図である。

- (1) ………パリスタ素体 (2) ……外周緑
- (3)(4)……内部電極 (5)(6)……先端部
- (7)(8)……無機絶縁層 (9)(10) ……外部電極
- (11)……… 艳 緑 外 装

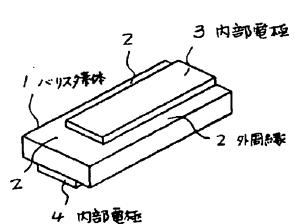
実用新案登録出順人マルコン電子株式会社



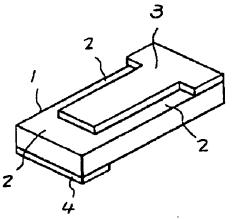
チップバリスタの斜視回



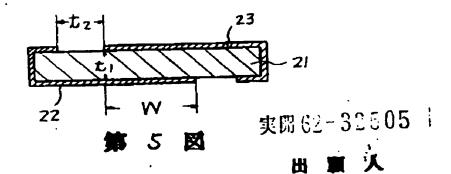
オ1図 A-A 新画図 第 2 **図** 



チップバリス物製造金中の斜視図第3図



他の実施例による チップバリスタの製造途中の斜視四 第 4 図



マルコン電子株式会社

44

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ other:

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.